

1,3,5-トリアジンを置換基とする電子欠乏性ホスフィン配位子の開発

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 公開日: 2018-07-02 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 安倍, 一実, Abe, Kazumi メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/00051382

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



学 位 論 文 要 約

電子欠乏性かつ立体障害の小さいホスフィン配位子として、トリアジニルホスフィンの開発を行った。従来の合成法と比べ効率的な方法によりビスおよびトリス(トリアジニル)ホスフィンを合成し、遷移金属触媒反応においてこれらの配位子が高い活性を示すことを見出した。また、合成したホスフィンを配位子とする Rh 錯体を用いた研究により、ビスおよびトリス(トリアジニル)ホスフィンに高度に電子欠乏性であるとわかった。さらに、トリス(トリアジニル)ホスフィンを配位子として持つ Pd 錯体の X 線結晶構造解析から、窒素原子周辺の立体障害が小さいトリアジニルホスフィンに特徴的なコンフォメーションをとることを発見した。